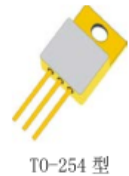


## 2DK35200T 型硅肖特基开关整流二极管

### 1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 TO-254 型金属封装。  
具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。  
器件的静电放电敏感度为 4000V，TO-254 型封装典型重量 8.5g。



### 2 质量等级及执行标准

G+ G 级：Q/RB1008QZ、QZJ840611；

### 3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

| 型号  | $I_{FM}^a$<br>$T_c=110^{\circ}\text{C}$<br>A | $V_{RM}$<br>V | $V_{RWM}$<br>V | $I_{FSM}^b$<br>$t_p=8.3\text{ms}$ , $T_c=25^{\circ}\text{C}$<br>A | $T_j$<br>$^{\circ}\text{C}$ | $T_{stg}$<br>$^{\circ}\text{C}$ | $R_{th(jc)}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$ |
|---|--|---------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2DK35200T   | 35   | 200           | 180            | 280   | $-65\sim 150$               | $-65\sim 150$                   | 2.0                                  |
| <sup>a</sup> $T_c$ 超过 $110^{\circ}\text{C}$ 时，按 $0.875\text{A}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 |  |               |                |   |                             |                                 |                                      |

### 4 主要电特性

主要电特性 ( $T_c=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ) 见表 3。

表 3 主要电特性

| 序号 | 符号 (单位)        | 测试条件  | 规范值                   |
|----|----------------|---|-----------------------|
| 1  | 正向压降 $V_{FM1}$ | $T_c=25^{\circ}\text{C}$ , $I_F=I_{FM}$ A     | $\leq 0.92\text{V}$   |
| 2  | 正向压降 $V_{FM2}$ | $T_c=-55^{\circ}\text{C}$ , $I_F=I_{FM}$ A    | $\leq 1.70\text{V}$   |
| 3  | 反向电流 $I_{R1}$  | $T_c=25^{\circ}\text{C}$ , $V_R=0.8 V_{RWM}$  | $\leq 10 \mu\text{A}$ |
| 4  | 反向电流 $I_{R2}$  | $T_c=125^{\circ}\text{C}$ , $V_R=0.8 V_{RWM}$ | $\leq 1\text{mA}$     |

### 5 特性曲线

#### 5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

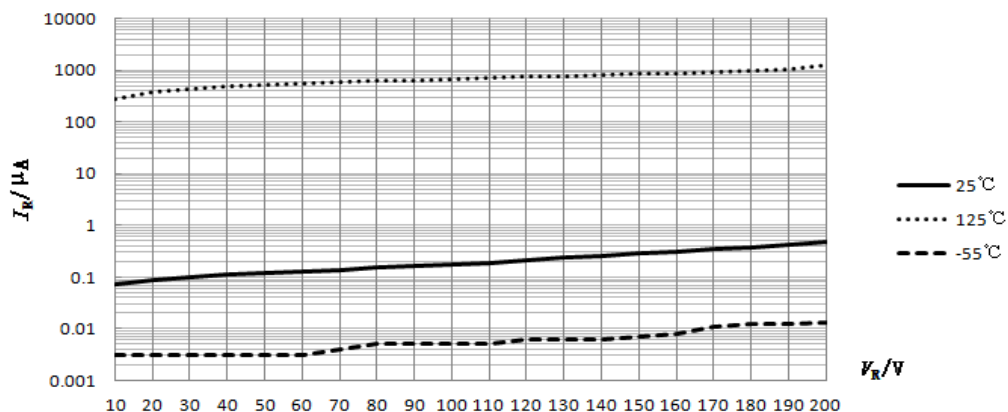


图 1  $I_R-V_R$  特性曲线



## 5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

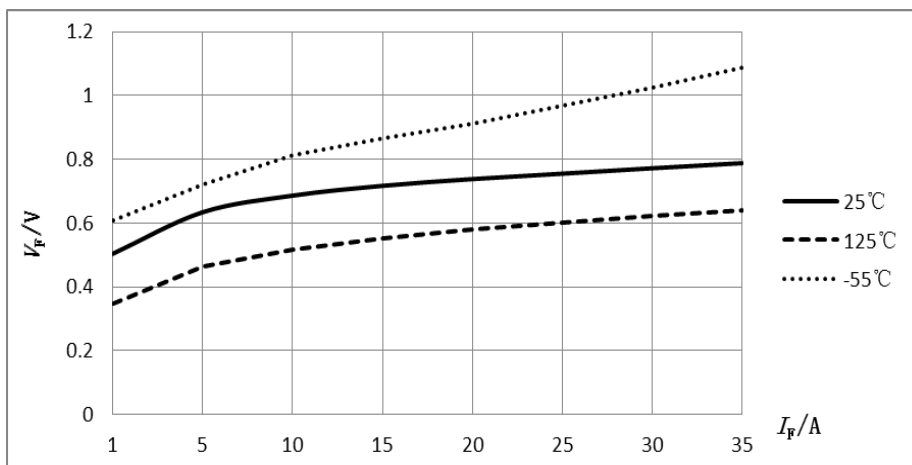
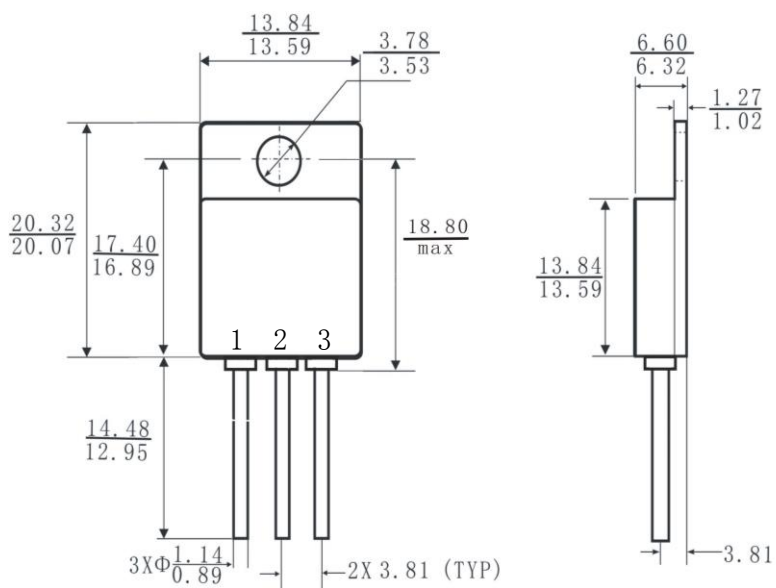


图 2  $V_F$ — $I_F$  特性曲线

## 6 外观尺寸 (T0-254 型)

单位: mm



引出端电极: 1-阳极 2-阴极 3-阳极

图 3 T0-254 外形尺寸